

パワートランジスタ

POWER TRANSISTORS

SHINDENGEN ELECTRIC MFG

32E D

8219387 0000021 0 SHEJ

電磁調理器用パワートランジスタ Power Transistors for Induction Cooker

T-33-09

品 名		絶 对 最 大 定 格 Absolute Maximum Ratings								電 気 的 ・ 熱 的 特 性 Electrical Characteristics										外 形 No. Outline No.
EIAJ No.	Type No.	V _{CE0} [V]	V _{CE0} [V]	V _{EB0} [V]	I _C [A]	I _B [A]	P _T [W]	T _{stg} [°C]	T _J [°C]	V _{CE0} (sus) [V]	h _{FE} (min)	V _{CE} (sat) [V]	V _{BE} (sat) [V]	θ _{jc} (max) [°C/W]	f _r (std) [MHz]	t _{on} (max) [μS]	t _s (max) [μS]	t _f (max) [μS]		
—	T30G40	800	400	7	30	5	200	-55~+150	+150	400	80	2	2.5	0.625	7	3	3	1	Fig. 10	

低飽和電圧パワートランジスタ Low Saturation Voltage Power Transistors

品 名		絶 対 最 大 定 格 Absolute Maximum Ratings									電 気 的 ・ 熱 的 特 性 Electrical Characteristics									外 形 No. Outline No.
EIAJ No.	Type No.	V _{CE0} [V]	V _{CEO} [V]	V _{EB0} [V]	I _C [A]	I _B [A]	P _T [W]	T _{stg} [°C]	T _J [°C]	V _{CE0} (sus) [V]	h _{FE} (min)	V _{CE} (sat) [V]	V _{BE} (sat) [V]	θ _{jo} (max) [°C/W]	f _r (std) [MHz]	t _{on} (max) [μS]	t _s (max) [μS]	t _f (max) [μS]		
2SA1679	TP5T4	-60	-40	-7	-5	-1.5	25	-55~+155	+150	-40	70	-0.3	-1.2	5	50	0.3	1.5	0.5	Fig. 8	
1598	TP7T4				-7	-1.5	25							5						
1599	TP10T4				-10	-1.5	25							5						
1600	TP12T4				-12	-2	30							4.16						
1601	TP15T4				-15	-2	45							2.77						
2SC4148	TP7S4	60	40	7	7	1.5	25	-55~+155	+150	40	70	0.3	1.2	5	50	0.3	1.5	0.5		
4149	TP10S4				10	1.5	25							5						
4150	TP12S4				12	2	25							5						
4151	TP15S4				15	2	30							4.16						

外形図 Outline Dimensions

[Unit: mm]

Fig. 10

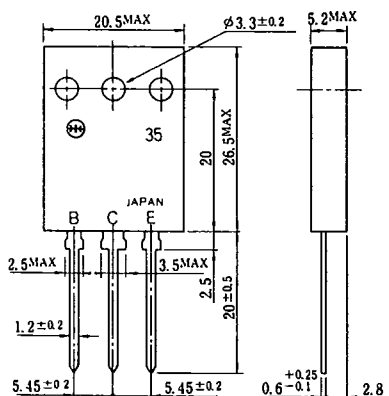


Fig. 11

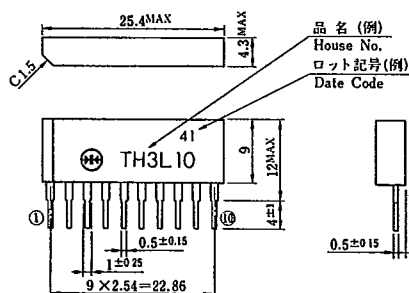
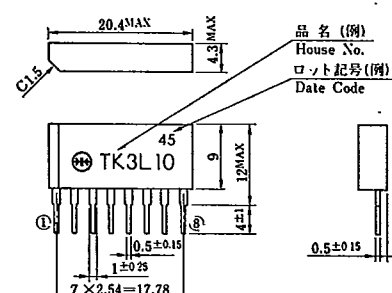


Fig. 12



POWER TRANSISTORS

SHINDENGEN ELECTRIC MFG

32E D

8219387 0000020 9 SHEJ

SHE J

ダーリントシパワートランジスタ

Darlington Power Transistors

T-33-29

品 名		絶 对 最 大 定 格 Absolute Maximum Ratings									電 氣 的 ・ 熱 的 特 性 Electrical Characteristics										外 形 No. Outline No.
EIAJ No.	Type No.	V _{CE0} [V]	V _{CE0} [V]	V _{EB0} [V]	I _C [A]	I _B [A]	P _T [W]	T _{stg} [°C]	T _j [°C]	V _{CEO} (sus) (min) [V]	h _{FE} (min)	V _{CE} (sat) (max) [V]	V _{BE} (sat) (max) [V]	θ _{jo} (max) [°C/W]	f _T (typ) [MHz]	t _{on} (max) [μS]	t _s (max) [μS]	t _f (max) [μS]			
2SD1022	T5L10	100	100	7	5	0.5	30	-55~+150	+150	—	1500	1.5	2	4.17	50	2	5	3	Fig. 7		
1023	20	200	200		8	0.5	50	-55~+150	+150	—	1500	1.5	2	2.5	50	2	8	5			
1024	T8L10	100	100		15	1	100	-55~+150	+150	—	1500	1.5	2	1.25	50	2	5	3			
1025	20	200	200	7	15	1	100	-55~+150	+150	—	1500	1.5	2	1.25	50	2	8	5	Fig. 9		
1026	T15L10	100	100														5	3			
1027	20	200	200														8	5			
1349	T7K40	500	400	12	7	0.5	50	-55~+150	+150	400	150	1.5	2	2.5	10	2	12	9	Fig. 7		
2SD1788	TP4L10	100	100	7	±4	0.3	25	-55~+150	+150	—	1500	1.5	2	5.0	50	2	12	5	Fig. 8		
1789	20	200	200																		
1790	6Z	60±10	60±10																		
1791	TP7L10	100	100	7	7	0.5	30	-55~+150	+150	—	1500	1.5	2	4.17	50	2	12	5	Fig. 8		
1792	20	200	200																		
1793	TP10L10	100	100																		
1794	20	200	200	7	10	0.5	50	-55~+150	+150	—	1500	1.5	2	2.5	50	2	12	5	Fig. 8		
1795	TP10K40	500	400																		
2SB1282	TP4J10	-100	-100																	-7	±4
1283	TP7J10			-7	-0.5	30	4.16														
1284	TP10J10			-10	-0.8	35	3.57														
1285	T15J10			-15	-1	100	1.25	Fig.													

ターリントランジスタアレイ

Darlington Transistor Arrays

品 名 Type No.	絶 对 最 大 定 格 Absolute Maximum Ratings							電 氣 的 ・ 熱 的 特 性 Electrical Characteristics							備 考 Remarks	外 形 No. Outline No.	
	V _{CEO}	V _{CE0}	V _{EB0}	I _C	I _B	P _T	T _{stg}	T _J	hFE	V _{OE} (sat) (max) [V]	V _{BE} (sat) (max) [V]	θ _{ja} (max) [C/W]	t _{on} (max) [μS]	t _s (max) [μS]			t _f (max) [μS]
	[V]	[V]	[V]	[A]	[A]	[W]	[°C]	[°C]	(min)								
TH3L10	100	100	7	±3	0.3	3.5	-55~+150	+150	1500	1.5	2	35	2	8	3	NPN×4	Fig. 11
3L20	200	200								±1.5	±2					NPN×2, PNP×2	
3C10	±100	±100	±7	±3	±0.3					±1.5	±2					PNP×4	
3J10	-100	-100	-7	±3	-0.3					-1.5	-2					NPN×4	
3L10Z*	60±10	60±10	7	±3	0.3					1.5	2		2	8	5	NPN×4	
5L10	100	100	7	5	0.5					1.5	2						
5L20	200	200															
TK3L10	100	100	7	±3	0.3	2.5	-55~+150	+150	1500	1.5	2	50	2	8	3	NPN×3	Fig. 12
3L20	200	200								±1.5	±2					PNP×3	
3J10	-100	-100	-7	±3	-0.3					±1.5	±2					PNP×3	
3L10Z*	60±10	60±10	7	±3	0.3					1.5	2					NPX×3	
5L10	100	100	7	5	0.5					1.5	2		2	8	5	NPN×3	
5L20	200	200															

※：CB間にツェナーダイオード入り。

With zener diode between collector and base.

外形図 Outline Dimensions

[Unit : mm]

Fig. 7

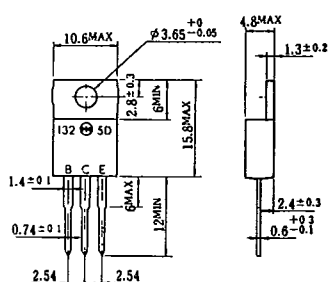


Fig. 8

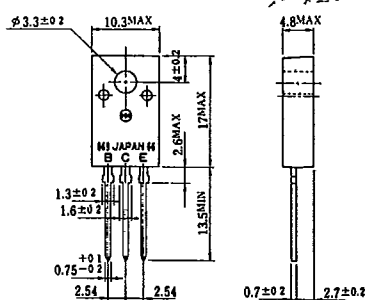
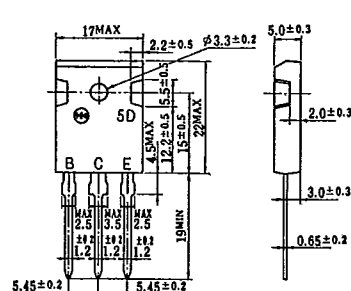


Fig. 9



パワートランジスタ

POWER TRANSISTORS

SHINDENGEN ELECTRIC MFG

32E D

8219387 0000021 0 SHEJ

電磁調理器用パワートランジスタ Power Transistors for Induction Cooker

T-33-09

品 名		絶 对 最 大 定 格 Absolute Maximum Ratings								電 気 的 ・ 熱 的 特 性 Electrical Characteristics									外 形 No. Outline No.
EIAJ No.	Type No.	V _{CE0} [V]	V _{CE0} [V]	V _{EB0} [V]	I _C [A]	I _B [A]	P _T [W]	T _{stg} [°C]	T _J [°C]	V _{CE0} (sus) [V]	hFE (min)	V _{CE} (sat) [V]	V _{BE} (sat) [V]	θ _{jc} (max) [°C/W]	f _r (std) [MHz]	t _{on} (max) [μS]	t _s (max) [μS]	t _f (max) [μS]	
—	T30G40	800	400	7	30	5	200	-55~+150	+150	400	80	2	2.5	0.625	7	3	3	1	Fig. 10

低飽和電圧パワートランジスタ Low Saturation Voltage Power Transistors

品 名		絶 対 最 大 定 格 Absolute Maximum Ratings									電 気 的 ・ 熱 的 特 性 Electrical Characteristics									外 形 No. Outline No.
EIAJ No.	Type No.	V _{CE0} [V]	V _{CEO} [V]	V _{EB0} [V]	I _C [A]	I _B [A]	P _T [W]	T _{stg} [°C]	T _J [°C]	V _{CE0} (sus) [V]	h _{FE} (min)	V _{CE} (sat) [V]	V _{BE} (sat) [V]	θ _{jo} (max) [°C/W]	f _r (std) [MHz]	t _{on} (max) [μS]	t _s (max) [μS]	t _f (max) [μS]		
2SA1679	TP5T4	-60	-40	-7	-5	-1.5	25	-55~+155	+150	-40	70	-0.3	-1.2	5	50	0.3	1.5	0.5	Fig. 8	
1598	TP7T4				-7	-1.5	25							5						
1599	TP10T4				-10	-1.5	25							5						
1600	TP12T4				-12	-2	30							4.16						
1601	TP15T4				-15	-2	45							2.77						
2SC4148	TP7S4	60	40	7	7	1.5	25	-55~+155	+150	40	70	0.3	1.2	5	50	0.3	1.5	0.5		
4149	TP10S4				10	1.5	25							5						
4150	TP12S4				12	2	25							5						
4151	TP15S4				15	2	30							4.16						

外形図 Outline Dimensions

[Unit: mm]

Fig. 10

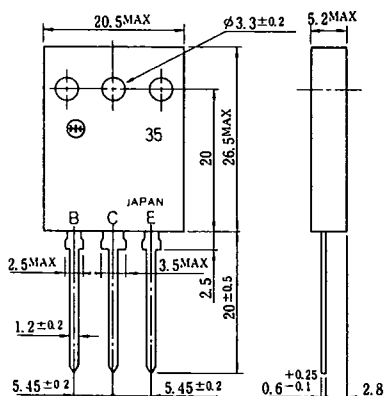


Fig. 11

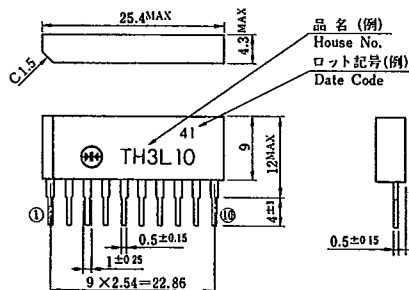


Fig. 12

